01;02;04

Генерация колебательно-возбужденных молекул H₂ в потоке водорода, протекающего сквозь цезий-водородный разряд

© Ф.Г. Бакшт, В.Г. Иванов

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург

Поступило в Редакцию 5 ноября 1996 г.

Теоретически исследуется электронно-колебательная кинетика в потоке молекулярного водорода, протекающего сквозь цезий-водородный разряд. Рассматривается колебательная накачка молекул водорода в разряде и исследуется колебательная релаксация в холодной зоне течения за разрядом. Показывается, что в холодной зоне может быть получено весьма сильное увеличение концентрации колебательно возбужденных молекул H₂.

1. В настоящее время в связи с плазмохимическими приложениями и в связи с проблемой объемно-плазменных источников ионов H^- [1] проявляется повышенный интерес к способам генерации достаточно высоко колебательно-возбужденных молекул H_2 . В [2–5] показано, что для эффективной генерации колебательно-возбужденных молекул H_2 можно использовать низковольтный цезий-водородный разряд. В настоящем сообщении излагаются первые результаты теоретического исследования колебательной кинетики в потоке водорода, протекающего сквозь плазму такого разряда. Показывается, что за счет соответствующей организации разряда и режима течения может быть получено весьма существенное (~ 10^3-10^4) увеличение концентрации возбужденных молекул в определенной части колебательного спектра по сравнению с их концентрацией в стационарном разряде.

2. Рассматриваемая модель течения иллюстрируется рис. 1, *а*. Поток водорода течет в плоском канале и проходит последовательно секции I и II. В секции I реализуется низковольтный Cs-H₂ разряд и осуществляется колебательная накачка молекул H₂. Здесь фор-

26



Рис. 1. a — схема течения водорода в канале: I — разрядная зона, II — течение газа в холодном канале; δ — колебательная функция распределения молекул H₂ в канале секции II: $1 - f_v(0)$ ($N_{\rm H_2}(0) = 3 \cdot 10^{16} {\rm cm}^{-3}$), $2 - f_v(x_m)$ ($x_m = 4.12 {\rm cm}$, $N_{\rm H_2}(x_m) = 1.94 \cdot 10^{16} {\rm cm}^{3}$), $3 - f_v(H)$ ($H = 7 {\rm cm}$, $N_{\rm H_2}(H) = 3.76 \cdot 10^{15} {\rm cm}^{-3}$), расчет с учетом колебательной релаксации молекул на стенках, $4 - f_v(H)$ то же, что кривая 3, расчет без учета колебательной релаксации молекул на стенках; 5 — вероятность образования иона H⁻ вследствие диссоциативного прилипания электрона к уровню v ($T_e = 0.7$ эВ).

мируется первоначальная колебательная функция распределения $f_v(0)$ молекул по колебательным уровням v. В следующей секции II поток водорода течет между холодными плоскостями, температура которых T близка к комнатной. Здесь за счет "триноровской" диффузии квантов в область больших v заселяется хвост распределения. На срезе канала (x = H) происходит истечение колебательнонакачанного газа со звуковой скоростью V_s .

3. Для определения образующейся в разряде. т. е. в секции I колебательной функции распределения молекул решалась система уравнений баланса [6] для заселенностей N_v колебательных уровней, учитывающая e - v обмен, v - v и v - t обмен, переходы между колебательными уровнями вследствие взаимодействия молекул Н₂ с атомами Cs, диссоциативное прилипание, ассоциативный отрыв и переходы между колебательынми уровнями H₂ за счет обдирки H⁻. Учитывалось также колебательное девозбуждение молекул H₂ на электродах в модели [2,5]. Для верхних колебательных уровней в этой модели взаимодействие со стенкой молекулы H₂, возбужденной на уровень v, приводит к образовнию после столкновения со стенкой примерно платообразного распределения по уровням v' от v' = v до v' = 0 [7]. Для нижнего возбужденного уровня v = 1 использование модели [2,5] приводит (в согласии с экспериментом [8,с.38]) к весьма малой вероятности $w_{10} = 10^{-3}$. Плазма считалась однородной по зазору. Параметры плазмы определялись в результате самосогласованного решения уравнений, описывающих баланс частиц и энергии в плазме и электронно-колебательную кинетику [5].

На рис. 1, б приведен пример расчетной функции распределения $f_v(0)$ молекул H₂ в разряде, нормированной на единицу. Исходные параметры разряда следующие: концентрация водорода $N_{\rm H_2}^{(0)} = 3 \times 10^{16} \, {\rm cm}^{-3}$, полная концентрация цезия $N_{\rm Cs}^{(0)} = 10^{14} \, {\rm cm}^{-3}$, межэлектродное расстояние $L = 0.3 \, {\rm cm}$, ток эмиссии катода $j_s = 10 \, {\rm A/cm}^2$, напряжение на разряде $U = 6.9 \, {\rm B}$. Расчетные значения электронной температуры и концентрации: $T_e = 0.7 \, {\rm sB}$, $n_e = 6.4 \cdot 10^{13} \, {\rm cm}^{-3}$.

4. При определении функции распределения молекул, устанавливающейся при течении газа в секции II, учитывалось уменьшение концентрации $N_{\rm H_2}$ молекул вследствие понижения давления по длине канала. Основные соотношения, определяющие течение водорода в канале секции II, можно получить, рассматривая аналогично [9]

течение Пуазейля для сжимаемого газа в длинном $(H \gg L)$ канале между вдумя параллельными плоскостями и приравнивая приближенно на срезе канала (x = H) среднюю по сечению скорость [10, с. 81] скорости звука V_s . Это приводит к следующему соотношению между длиной H канала и давлением p_s на срезе канала, т. е. в месте истечения газа:

$$H/L = (R_s/24)(c_p/c_v)^{-1} \left[(p_0/p_s)^2 - 1 \right], \tag{1}$$

Здесь p_0 — давление водорода при x = 0, т. е. приближенно давление в разряде; $R_s = \rho_s L V_s / \eta$ — число Рейнольдса, рассчитанное по скорости звука V_s и ширине L канала; η — вязкость водорода [11, с. 365]; $\rho_s = M_{\rm H_2} p_s / kT$ — плотность газа при x = H.

Распределение давления p(x) по длине канала в секции II дается выражением

$$p(x) = \left[p_0^2 - (p_0^2 - p_s^2) \cdot x/H\right]^{1/2}.$$
 (2)

В расчете длина H канала варьировалась для получения наибольшей заселенности на срезе канала $N_{v^*}(H)$ для какого-либо уровня v^* в верхней части спектра. В рассматриваемом ниже примере $v^* = 10$. Отметим, что распределение по длине заселенностей $N_v(x)$ уровней в верхней части спектра получается немонотонным, так что максимальное значение заселенности реализуется в некоторой точке $x = x_m < H$ (рис. 2).

Колебательная функция распределения молекул *H*₂ в секции II определялась из решения следующей системы уравнений:

$$\frac{d(N_v \cdot V)}{dx} = I_v^{(vv)} \{N_v\} + I_{vM}^{vt} \{N_v\} + \frac{1}{\tau} \left[\sum_{v'>v} N_{v'} w_{v'v} - N_v \sum_{v'
(3)
$$(v, v' = 0, 1, 2, \dots, 14)$$$$

где $V(x) = V_s p_s / p(x)$ — средняя по сечению скорость течения газа в канале.

Слагаемые в правой части (3) описывают v - v и v - t обмен с молекулами H₂ и колебательную релаксацию молекул H₂ на стенках: $\tau \approx I^2/D_{sd}$ — среднее время дрейфа молекул H₂ между электродами. D_{sd} — коэффициент самодиффузии молекул H₂ [11, с. 375], $w_{vv'}$ — вероятность колебательного девозбуждения на стенке. В



Рис. 2. Изменение абсолютных заселенностей колебательных уровней молекул H_2 по длине канала в секции II. Сплошные линии — расчет с учетом колебательнрой релаксации на стенках. Штрихи — расчет без учета колебательной релаксации на стенках.

качестве начальных условий к уравнениям (3) используются заселенности $N_v(0)$ в разряде. Предполагается, что Cs вымораживается на холодных стенках и не влияет на колебательную релаксацию H₂ в секции II.

5. Результаты расчетов изображены на рис. 1, б и 2. Ha рис. 1, δ представлены нормированные на единицу функции $f_v(H)$ в истекающей из канала струе и $f_v(x_m)$, соответствующая максимальной накачке уровня $v^* = 10$ внутри канала. Штрихами показна функция распределения на срезе (x = H), рассчитанная без учета колебательного девозбуждения молекул. Н₂ на стенках канала. На рис. 2 приведены абсолютные заселенности $N_v(x)$ ряда колебательных уровней в верхней части спектра. Сплошные и штриховые кривые на рис. 2 рассчитаны соответственно с учетом и без учета колебательного девозбуждения молекул Н2 на стенках. Из рис. 1, б видно, что в процессе дрейфа в канале в определенной части колебательного спектра (v = 8-11) происходит весьма сильное увеличение заселенностей колебательно-возбужденных состояний. В значительной степени это относится и к тем колебательным уровням, колебательная накачка которых существенна для генерации ионов H^- за счет диссоциативного прилипания. Это иллюстрируется рис. 1, б, где отложена величина $\gamma_v(T_e) = K_v(T_e) \cdot f_v(H) / \sum\limits_v K_v(T_e) imes$ $f_v(H)$, представляющая собой нормированную на единицу вероятность образования иона Н⁻ вследствие прилипания электрона к молекуле H₂, возбужденной на уровень v [12]. Поскольку при инъекции молекул в камеру большого объема время колебательной релаксации существенно увеличивается, рассмотренный способ формирования колебательных функций распределения молекул Н2 может быть перспективным для двухкамерных источников ионов H⁻. В таких источниках процессы колебательной накачки H₂ и процессы генерации H⁻ за счет диссоциативного прилипания электронов к колебательно-возбужденным молекулам разделены в пространстве.

Работа выполнена при поддержке гранта INTAS (грант № 94– 316) и гранта Международного научного фонда и Российского правительства (грант № NTZ000).

Список литературы

- Bacal M., Skinner D.A. // Comments At. Mol. Phys. 1990. V. 23. N 6. P. 283–289.
- [2] Бакшт Ф.Г., Иванов В.Г. // ЖТФ. Т. 62. В. 2. С. 195–199.
- [3] Бакшт Ф.Г., Дюжев Г.А., Елизаров Л.И., Иванов В.Г., Никитин А.Г., Школьник С.М. // Письма в ЖТФ. 1993. Т. 19. В. 22. С. 39–43.
- [4] Бакшт Ф.Г., Иванов В.Г., Никитин А.Г., Школьник С.М. // Письма в ЖТФ. 1994. Т. 20. В. 22. С. 83–87.
- [5] Baksht F.G., Djuzhev G.A., Elizarov L.I., Ianov V.G., Kostin A.A., Shkol'nik S.M. // Plasma Sources Sci. Technol. 1994. V. 3. N 2. P. 88–98.
- [6] Бакшт Ф.Г., Иванов В.Г. // ЖТФ. 1996. Т. 66. В. 9. С. 59–63.
- [7] Hiskes J.R., Karo A.M. // J. Appl. Phys. 1984. V. 56. N 7. Р. 1927–1938.
 [8] Неравновесная колебательная кинетика / Под ред. М. Капителли. М.: Мир, 1989. 391 с.
- [9] Дэшман С. Научные основы вакуумной техники. М.: Мир, 1964. 714 с.
- [10] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. М.: Наука, 1986.
- [11] Физические величины / Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова.
 М.: Энергоиздат, 1991. 1230 с.
- [12] Wadehra J.M. // Phys. Rev. A. 1984. V. 29. N 1. P. 106-110.